

а 2016 0129

Изобретение относится к технологии производства диодов Шоттки на основе органического полупроводника и может быть использовано для преобразования солнечной энергии в электрическую энергию.

Способ получения диода Шоттки на основе ZnPc включает первоначальное растворение фталоцианина цинка в муравьиной кислоте, ультразвуковую обработку раствора, последующее его легирование йодом и осаждение полученного раствора на подложку из ITO, покрытую PEDOT:PSS, методом капельного осаждения или методом центрифугирования.

П. формулы: 1